

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 5 月 1 4 日
Date of Application:

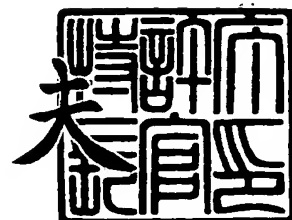
出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 1 3 5 2 6 7
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 1 3 5 2 6 7]

出 願 人 株式会社日立製作所
Applicant(s):

2 0 0 3 年 1 0 月 2 7 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 H03006691A

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G06F 3/22

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県日立市大みか町七丁目 1 番 1 号 株式会社日立製作所日立研究所内

【氏名】 楠 敏明

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県日立市大みか町七丁目 1 番 1 号 株式会社日立製作所日立研究所内

【氏名】 佐川 雅一

【発明者】

【住所又は居所】 茨城県日立市大みか町七丁目 1 番 1 号 株式会社日立製作所日立研究所内

【氏名】 鈴木 睦三

【特許出願人】

【識別番号】 000005108

【氏名又は名称】 株式会社 日立製作所

【代理人】

【識別番号】 100075096

【弁理士】

【氏名又は名称】 作田 康夫

【電話番号】 03-3212-1111

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013088

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 画像表示装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

下部電極と上部電極、その間に挟持される電子加速層を有し、該下部電極と該上部電極間に電圧を印加することで上記上部電極側より電子を放出する薄膜型電子源アレイと、蛍光面とを有する画像表示装置において、電子加速層は、1本の上記下部電極と、該下部電極と直交し上記上部電極へ給電する2本の上部バス電極に挟まれた空間の直交部に形成され、該上部バス電極側面の一方は上記上部電極と接続され、反対側の側面は庇構造によって該上部電極を切断していることを特徴とする画像表示装置。

【請求項 2】

上記上部バス電極はスペーサ電位を与えるスペーサ電極を兼ねていることを特徴とする請求項 1 記載の画像表示装置。

【請求項 3】

上記上部バス電極は画素ピッチ内で1本ずつ形成されていることを特徴とする請求項 1 記載の画像表示装置。

【請求項 4】

上記薄膜型電子源アレイをマトリクス状に配置した画像表示領域内においては、何れか一方向の電極の上面より見た形状はストライプ状パターンにしたストライプ電極であることを特徴とする請求項 1 記載の画像表示装置。

【請求項 5】

上記薄膜型電子源アレイをマトリクス状に配置した画像表示領域内においては、電極の上面より見た形状はストライプ状パターンにしたストライプ電極であることを特徴とする請求項 1 記載の画像表示装置。

【請求項 6】

下部電極と上部電極、その間に挟持される電子加速層を有し、該下部電極と該上部電極間に電圧を印加することで上記上部電極側より電子を放出する薄膜型電子源アレイと、蛍光面とを有する画像表示装置において、電子加速層は、1本の

データ電極と、該データ電極と直交する 2 本の走査電極に挟まれた空間の直交部に形成され、該走査電極側面の一方は上記上部電極と接続され、反対側の側面は庇構造によって該上部電極を切断していることを特徴とする画像表示装置。

【請求項 7】

上記走査電極はスペーサの電位を設定するスペーサ電極を兼ねていることを特徴とする請求項 6 記載の画像表示装置。

【請求項 8】

上記走査電極は画素ピッチ内で 1 本ずつ形成されていることを特徴とする請求項 6 記載の画像表示装置。

【請求項 9】

上記薄膜型電子源アレイをマトリクス状に配置した画像表示領域内においては、何れか一方向の電極の上面より見た形状はストライプ状パターンにしたストライプ電極であることを特徴とする請求項 6 記載の画像表示装置。

【請求項 10】

上記薄膜型電子源アレイをマトリクス状に配置した画像表示領域内においては、電極の上面より見た形状はストライプ状パターンにしたストライプ電極であることを特徴とする請求項 6 記載の画像表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、自発光型フラットパネルディスプレイに係り、薄膜型電子源アレイを用いた画像表示装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

微少で集積可能な冷陰極を利用するディスプレイは、FED(Field Emission Display)と呼称される。冷陰極には、電界放出型電子源とホットエレクトロン型電子源に分類され、前者には、スピント型電子源、表面伝導型電子源、カーボンナノチューブ型電子源等が属し、後者には金属—絶縁体—金属を積層したMIM (Metal-Insulator-Metal) 型、金属—絶縁体—半導体を積層したMIS (Metal-Insulat

or-Semiconductor) 型、金属—絶縁体—半導体—金属型等の薄膜型電子源がある。

【特許文献 1】

特開平7-65710号公報

【特許文献 2】

特開平10-153979号公報

【非特許文献 1】

J. Vac. Sci. Technol. B11 (2) p.429-432 (1993)

【非特許文献 2】

high-efficiency-electro-emission device、Jpn.J.Appl. Phys.、vol 36、p L939

【非特許文献 3】

Electroluminescence、応用物理 第63巻、第6号、592頁

【非特許文献 4】

応用物理 第66巻、第5号、437頁

MIM型については例えば特許文献 1、金属—絶縁体—半導体型についてはMOS型（非特許文献 1）、金属—絶縁体—半導体—金属型ではHEED型（非特許文献 2 などに記載）、EL型（非特許文献 3 などに記載）、ポーラスシリコン型（非特許文献 4 などに記載）などが報告されている。

【0 0 0 3】

MIM型電子源については、例えば特許文献 2 に開示されている。MIM型電子源の構造と動作原理を図2に示す。上部電極13と下部電極11との間に駆動電圧 V_d を印加して、絶縁層12内の電界を1～10MV/cm程度にすると、下部電極11中のフェルミ準位近傍の電子はトンネル現象により障壁を透過し、電子加速層である絶縁層12の伝導帯へ注入されホットエレクトロンとなり、上部電極13の伝導帯へ流入する。これらのホットエレクトロンのうち、上部電極13の仕事関数 ϕ 以上のエネルギーをもって上部電極13表面に達したものが真空21中に放出される。

【0 0 0 4】

【発明が解決しようとする課題】

画像表示装置などに適用する薄膜型電子源アレイは、低コスト化を実現するため、簡易な構造とプロセスで製造できることが望ましい。薄膜型電子源は面状電子源であり、電界放出型電子源のように電界を集中させるための微細構造が不要である。そのため、薄膜型電子源のデバイスサイズは画素ピッチレベルと大きくすることができるので、高精度のパターニングは不要であり、安価な製造装置が使える。

【0005】

パターン化加工においては、縦方向および横方向の2方向にパターン合わせ精度を要求されるパターンに比べて、縦方向または横方向のいずれか1方向のみしかパターン合わせ精度を必要としないパターンを用いると、更に加工が容易になる。本明細書ではこのように1方向のみしかパターン合わせ精度を必要としない形状を、1次元方向にのみ精度が必要という意味で「ストライプ状」または「ストライプ形状」と呼ぶ。またストライプ状パターンの電極を「ストライプ電極」とあるいは「ストライプ状電極」と呼ぶ。

特にパターン化方法としてスクリーン印刷などの印刷法を用いる場合には、ストライプ状パターンは、パターンの延びを許容するので、好ましい。

【0006】

電子源基板を、電子源をマトリクス状に配置した画像表示領域と、端子取り出し部などを配置する周辺領域とに分けて考える。画像表示領域では、周辺領域に比べて加工精度およびパターン合わせ精度が一般に高い。したがって、画像表示領域内のパターン形状をストライプ状にすることが大切である。周辺領域は加工精度が緩く、合わせパターン数も一般にすくないので、ストライプ状でにする必要は必ずしも無い。

さらに加工を容易にするには、画素ピッチ内のストライプ電極の数を少なくし、加工精度を緩くするのが好ましい。例えば1サブピクセルを走査線、データ線各1本で構成するのがよい。

一方、薄膜型電子源は電子加速層上にホットエレクトロンが透過できる薄い上部電極を形成する。上部電極を加工する際には電子加速層にダメージを与えず、かつ電子放出を妨げないように、上部電極をレジストなどで汚染しないで加工しな

ければならない。そのため、上部電極を自己整合的に分離する方法が好ましい。

【0007】

さらに、FEDとして使用するには電子源基板と蛍光面基板を支持するスペーサが必要である。スペーサは帯電を防止するため導電処理を施す必要があり、さらにそれぞれの基板で電位を固定するための電極に接続されている必要がある。したがってFEDに薄膜型電子源アレイを用いる場合にも、薄膜型電子源アレイ中にスペーサ電極を設けることが好ましい。

【0008】

【課題を解決するための手段】

本発明の目的は、薄膜型電子源の電子加速層を、上部電極を自己整合的に分離できる機能を持った隣接する2本のストライプ形状の走査線で挟み、その上にスペーサを配置することにより実現することができる。

【0009】

【発明の実施の形態】

【第1の実施例】

上記目的を実現する本発明の第一の実施の形態をMIM電子源を例に図3～10、図1で説明する。

はじめにガラス等の絶縁性の基板10上に下部電極11用の金属膜を成膜する(図3)。下部電極11の材料としてはAlやAl合金を用いる。AlやAl合金を用いたのは、陽極酸化により良質の絶縁膜を形成できるからである。ここでは、Ndを2原子量%ドープしたAl-Nd合金を用いた。成膜には例えば、スパッタリング法を用いる。膜厚は300 nmとした。成膜後はパターンニング工程、エッチング工程によりストライプ形状の下部電極11を形成した(図4)。電極幅は画像表示装置のサイズや解像度により異なるが、そのサブピクセルピッチ程度、大体100～200ミクロン程度とする。エッチングは例えば燐酸、酢酸、硝酸の混合水溶液でのウェットエッチングを用いる。この電極は幅の広い簡易なストライプ構造のため、電極のパターンニングは安価なプロキシミティ露光や、印刷法などで行うことができる。

【0010】

次に、電子放出部を制限し、下部電極エッジへの電界集中を防止する保護絶縁

層14と、絶縁層12を形成する。まず下部電極11上の電子放出部となる部分をレジスト膜25でマスクし、その他の部分を選択的に厚く陽極酸化し、保護絶縁層14とする(図5)。化成電圧を100Vとすれば、厚さ約136 nmの保護絶縁層14が形成される。つぎにレジスト膜25を除去し残りの下部電極11の表面を陽極酸化する。例えば化成電圧を6Vとすれば、下部電極11上に厚さ約10 nmの絶縁層12が形成される(図6)。

【0011】

次に層間膜15と、上部電極13への給電線となる上部バス電極、およびスペーサを配置するためのスペーサ電極となる金属膜を例えばスパッタリング法等で成膜する(図7)。層間膜15としては、例えばシリコン酸化物やシリコン窒化膜、シリコンなどを用いることができる。ここでは、シリコン窒化膜を用い膜厚は100nmとした。この層間膜15は、陽極酸化で形成する保護絶縁層14にピンホールがあった場合、その欠陥を埋め、下部電極11と上部バス電極間の絶縁を保つ役割を果たす。金属膜は積層構造とし、金属膜下層16として例えばAl-Nd合金、金属膜上層17として例えばCuやCrなどの各種の金属材料を用いることができる。ここでは金属膜下層16にAl-Nd合金、金属膜上層17としてCuを用いた。

続いて、パターニングとエッチング工程により金属膜上層17を、下部電極11とは直交するストライプ電極に加工する。ストライプ電極は1ピクセル中で1本形成する(図8)。

【0012】

続いて、パターニングとエッチング工程により金属膜下層16を、下部電極11とは直交するストライプ電極を1ピクセル中で1本形成する(図9)。その際ストライプ電極の片側では金属膜上層17より張り出させて、後の工程で上部電極との接続を確保するコンタクト部とし、ストライプ電極の反対側では金属膜上層17をマスクとしてアンダーカットを形成し、後の工程で上部電極13を分離する底を形成する。これにより上部電極13への給電を行う上部バス電極を形成することができる。

続いて層間膜15を加工し、電子放出部を開口する。電子放出部はピクセル内の1本の下部電極11と、下部電極11と直交する2本のストライプ電極に挟まれた空間

の直交部の一部に形成する。エッチングは、例えば CF_4 や SF_6 を主成分とする用いたドライエッチングによって行うことができる（図10）。

【0013】

最後に上部電極13膜の成膜を行う。成膜法は例えばスパッタ成膜を用いる。上部電極13としては例えばIr、Pt、Auの積層膜を用い膜厚は例えば6 nmとした。この時、上部電極13は、隣接するストライプ形状の走査電極の片側で、アンダーカットにより切断される。一方、ストライプ形状の走査電極の反対側では金属膜下層16のコンタクト部により断線を起こさずに接続され、層間膜15上を経て、絶縁層12を覆い給電される構造となる（図11）。

【0014】

図1は本発明の陰極を用いたディスプレイの一部を示したものである。表示側基板はコントラストを上げる目的のブラックマトリクス120、赤色蛍光体111、緑色蛍光体112と青色蛍光体113とからなる。蛍光体としては、例えば赤色に $\text{Y}_2\text{O}_2\text{S}:\text{Eu}$ (P22-R)、緑色に $\text{ZnS}:\text{Cu}, \text{Al}$ (P22-G)、青色に $\text{ZnS}:\text{Ag}, \text{Cl}$ (P22-B)を用いる。ブラックマトリクス120は図面の説明上、画像表示部の一部のみ図示している。

【0015】

スペーサ30は、陰極基板の上部バス電極の金属層上層17上に配置し、蛍光面基板のブラックマトリクス120の下に隠れるように配置する。下部電極11は信号線回路50へ結線し、上部バス電極は走査線回路60に結線する。薄膜型電子源では走査線に印加させる電圧は数V～数10Vと、数KVを印加する蛍光面に対し十分低く、スペーサの陰極側に対しほぼ接地電位に近い電位を与えることができる。このように、本発明の陰極構造では、データ線となる下部電極11、走査線兼スペーサ電極となる上部バス電極が1サブピクセル内で1本ずつの簡単なストライプ電極により形成され、さらに上部電極13を自己整合的に分離できる機能が備わっており、安価で精度の低いパターンニング方法により電極を形成することができる。

【0016】

【発明の効果】

以上により、各サブピクセル毎にパターンニングの容易なストライプ電極を用い

て薄膜電子源を作成することができ、さらに上部電極を自己整合的に加工することができるので、高歩留まりで低コストの画像表示装置を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の薄膜型電子源を用いた表示装置を示す図である。

【図 2】

薄膜型電子源の動作原理を示す図である。

【図 3】

本発明の薄膜型電子源の製法を示す図である。

【図 4】

本発明の薄膜型電子源の製法を示す図である。

【図 5】

本発明の薄膜型電子源の製法を示す図である。

【図 6】

本発明の薄膜型電子源の製法を示す図である。

【図 7】

本発明の薄膜型電子源の製法を示す図である。

【図 8】

本発明の薄膜型電子源の製法を示す図である。

【図 9】

本発明の薄膜型電子源の製法を示す図である。

【図 10】

本発明の薄膜型電子源の製法を示す図である。

【図 11】

本発明の薄膜型電子源の製法を示す図である。

【符号の説明】

10・・・基板、11・・・下部電極、12・・・絶縁層、13・・・上部電極、14・・・保護絶縁層、15・・・層間膜、16・・・金属膜下層、17・・・金属膜上層、

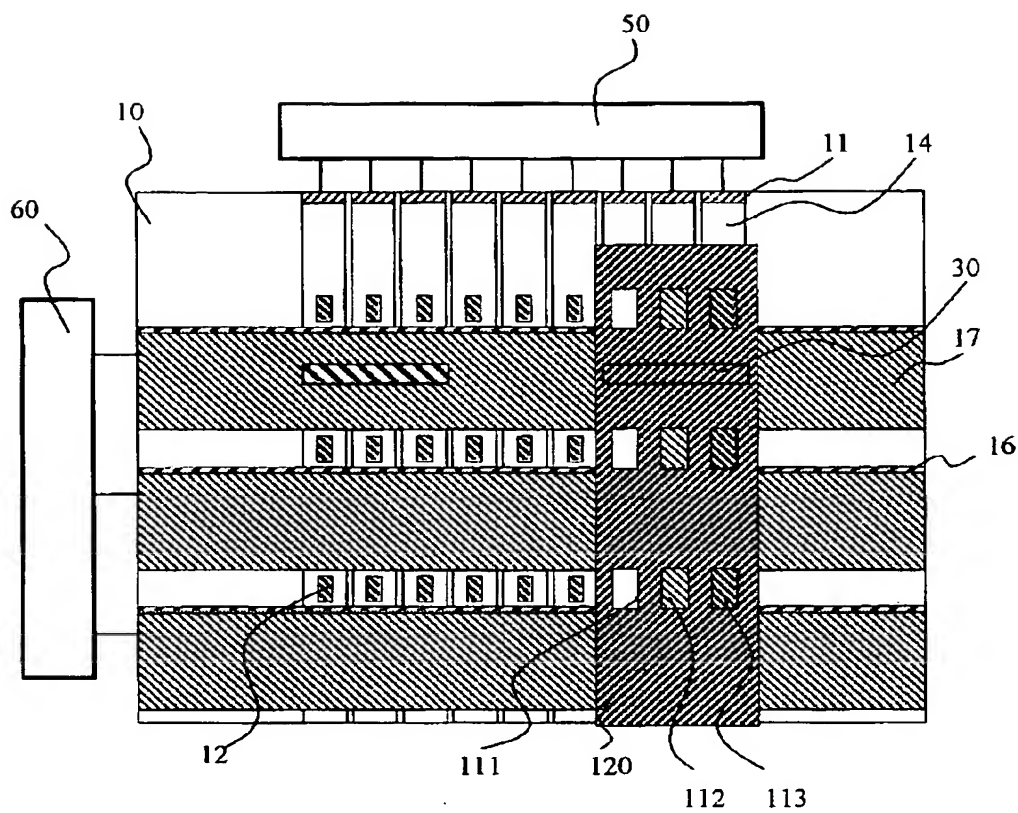
21 . . . 真空、25 . . . レジスト膜、30 . . . スペーサ、50 . . . 下部電極駆動回路、60 . . . 上部電極駆動回路、111 . . . 赤色蛍光体、112 . . . 緑色蛍光体、113 . . . 青色蛍光体、120 . . . ブラックマトリクス。

【書類名】

図面

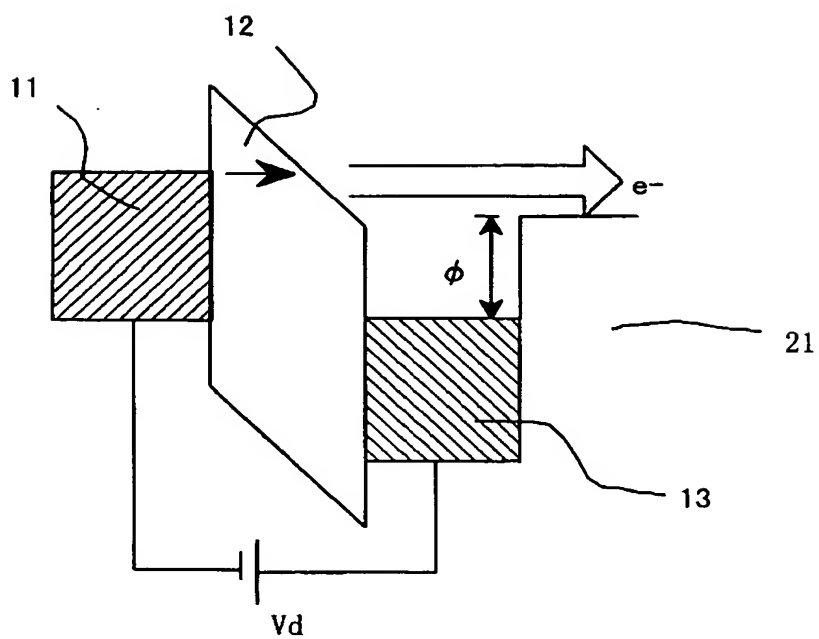
【図 1】

図1



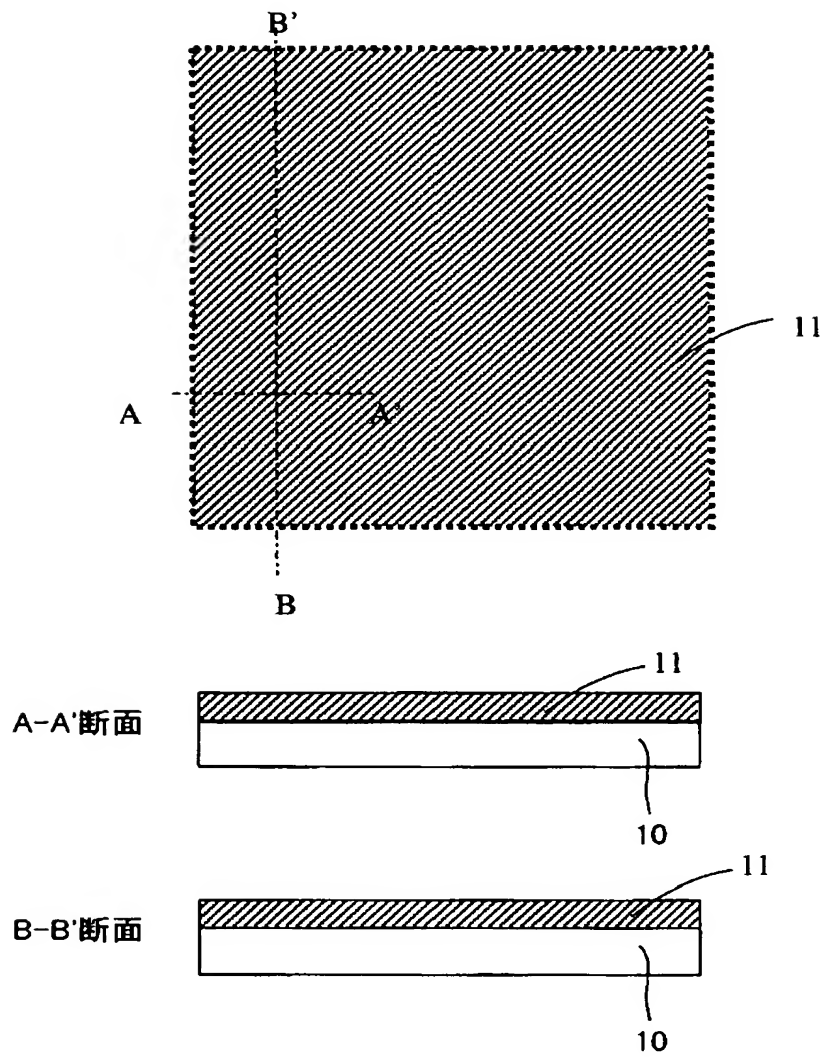
【図 2】

図2



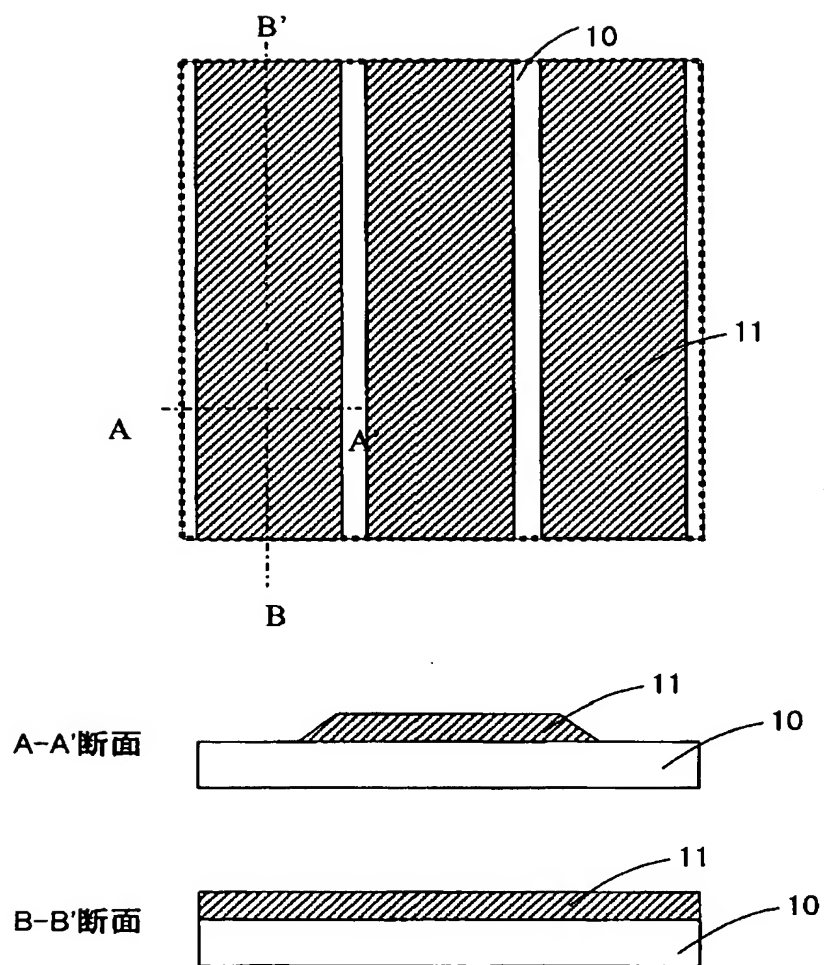
【図 3】

図3



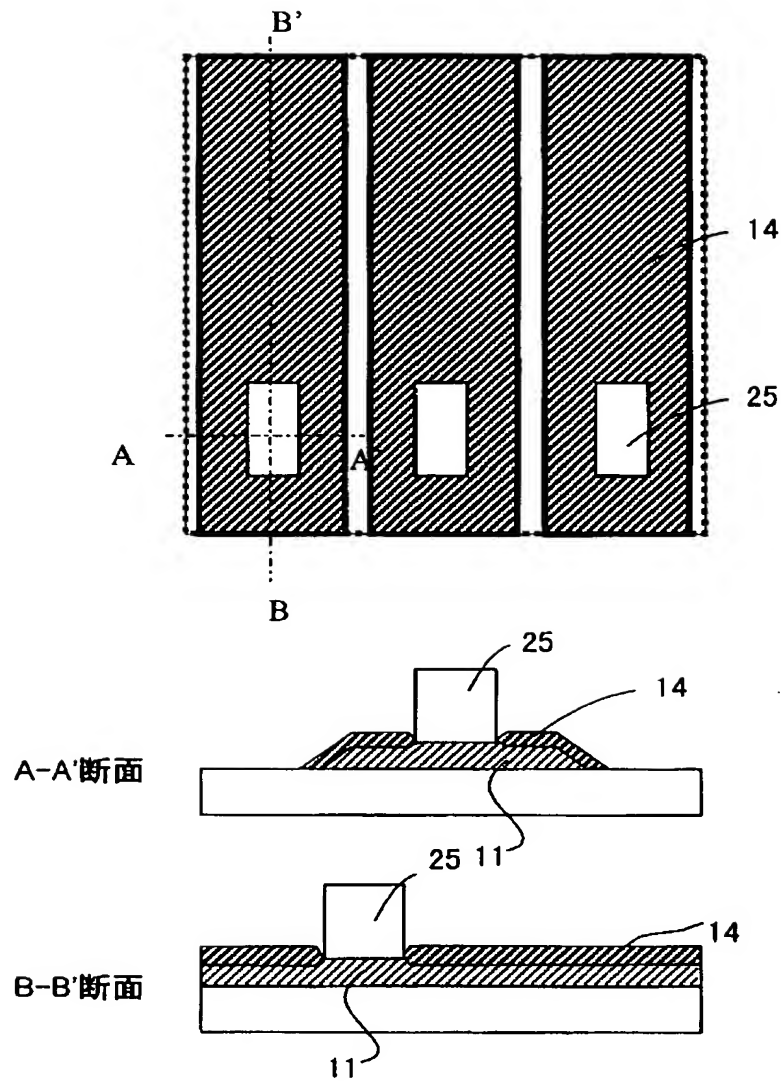
【図 4】

図4



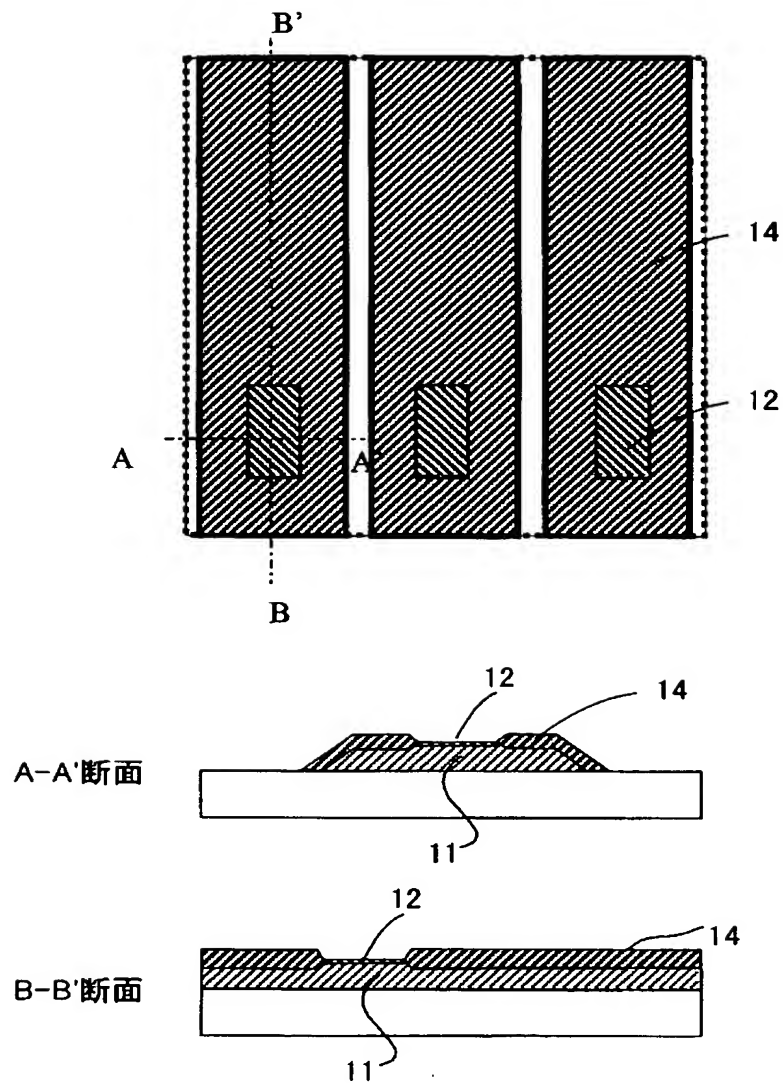
【図 5】

図5



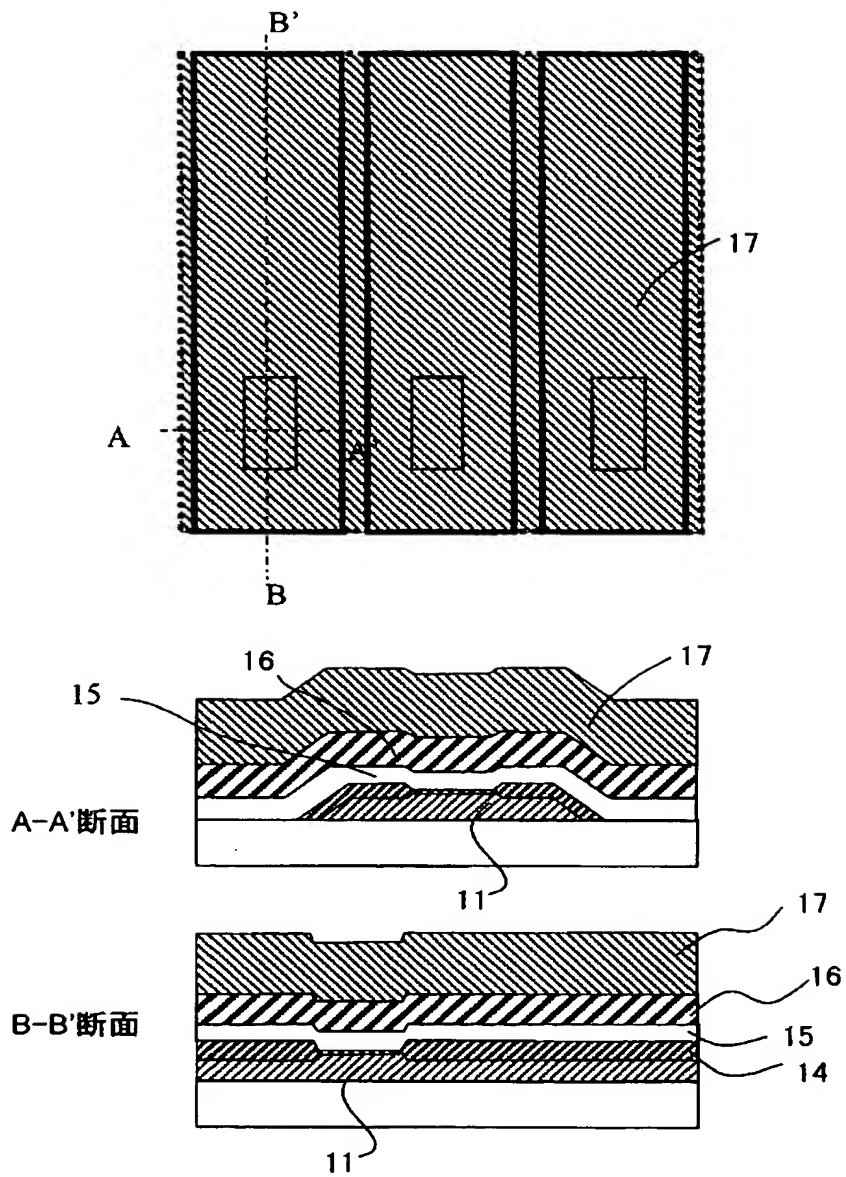
【図 6】

図6



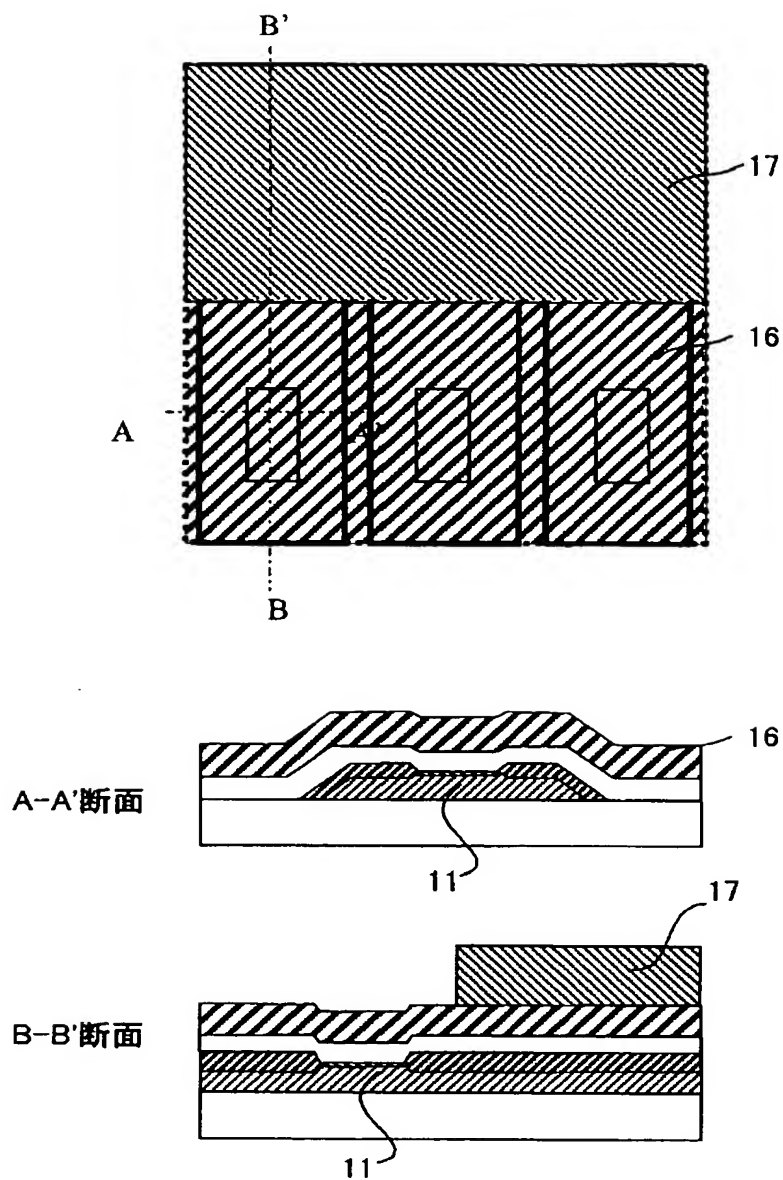
【図 7】

図7



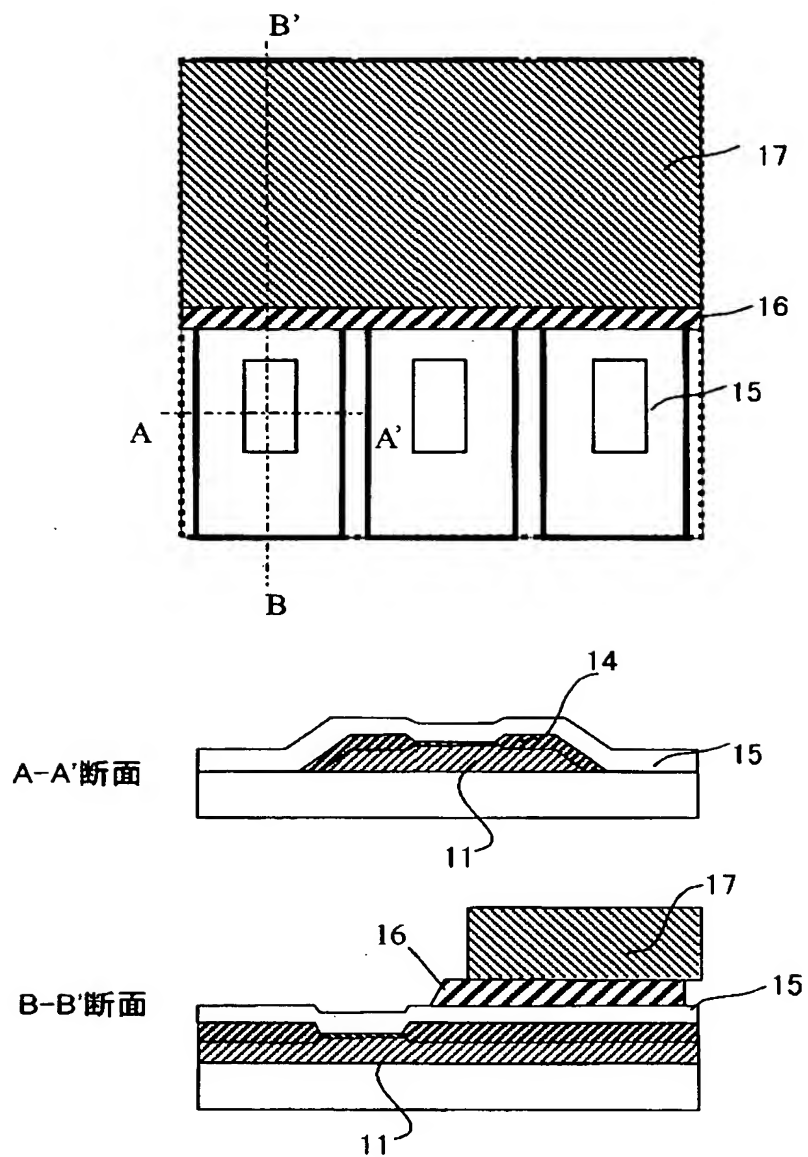
【図 8】

図8



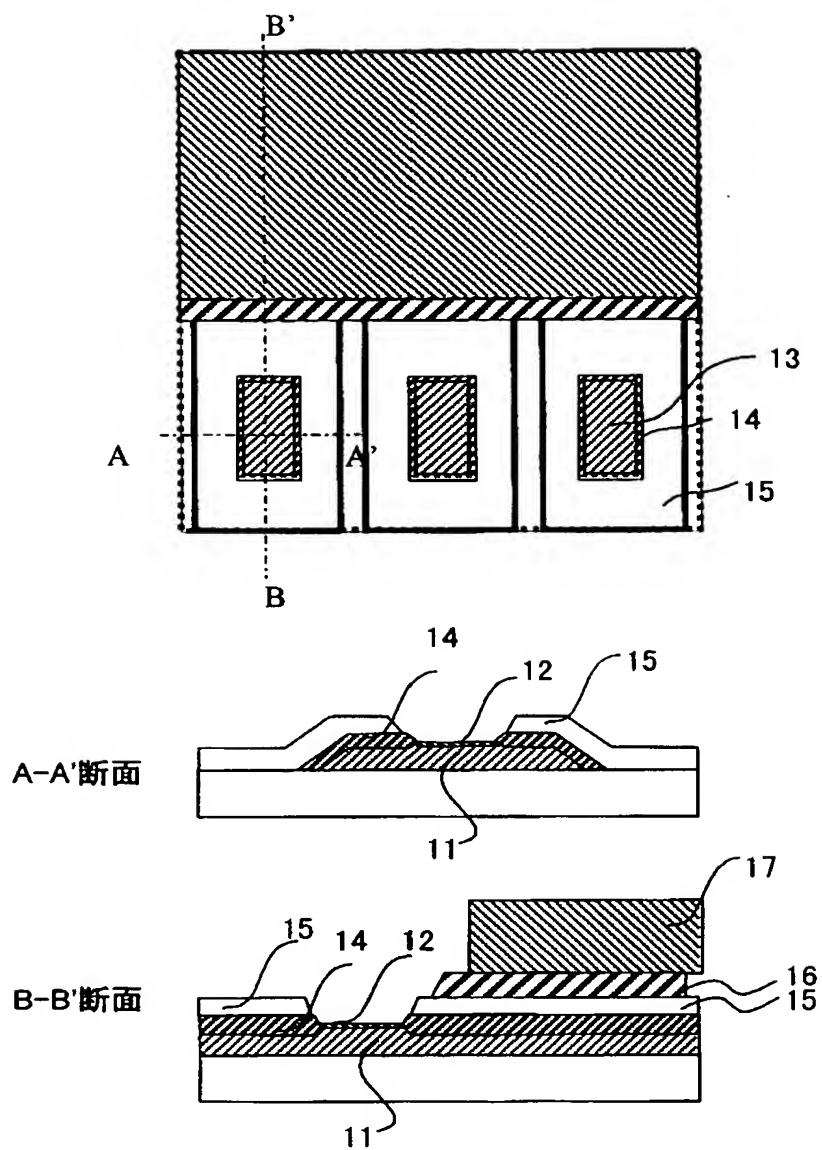
【図 9】

図9



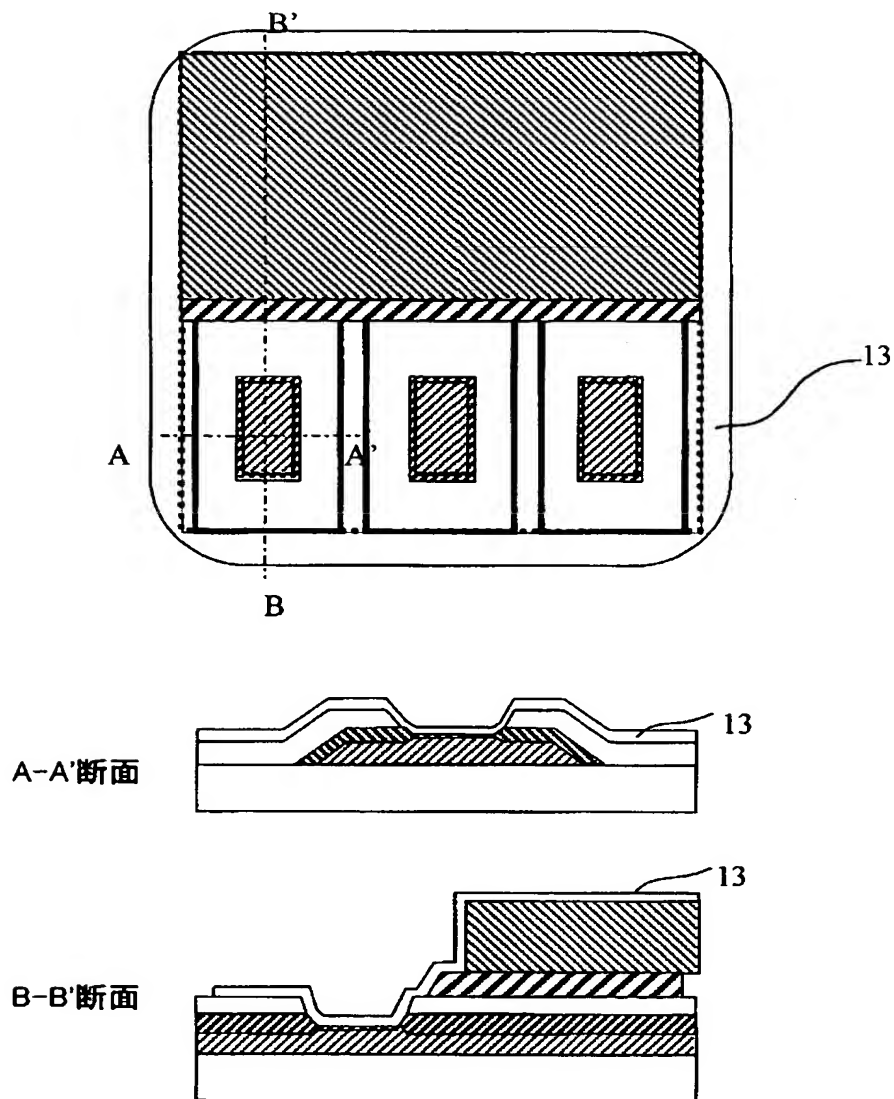
【図10】

図10



【図 11】

図 11



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 低コスト化に必要な簡易な構造と、上部電極の自己整合的な加工、スペーサを設置する構造を満たす電子源構造により、簡易な構造、プロセスを有する薄膜型電子源を用いた画像表示装置を実現する。

【解決手段】 パターン精度の要求が低いストライプ電極を各サブピクセル毎最少数用いて、上部電極の自己整合分割、スペーサ線の作成を行う。

【選択図】 図 1

認定 - 付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 3 - 1 3 5 2 6 7
受付番号	5 0 3 0 0 7 9 4 9 4 6
書類名	特許願
担当官	第七担当上席 0 0 9 6
作成日	平成 1 5 年 5 月 1 5 日

< 認定情報・付加情報 >

【提出日】	平成15年 5月14日
-------	-------------

次頁無

特願 2003-135267

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000005108]

1. 変更年月日

1990年 8月31日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

氏 名

株式会社日立製作所